

2SC4532

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ

- 高精度ダイスレベル水平出力用
- カラータレレベル水平出力用
- カラータレレベルソース電流出力用

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CB0} \geq 1700V$
- ・ 飽和電圧が低い。 : $V_{CE(sat)} \leq 5V$
- ・ スイッチング時間が速い。

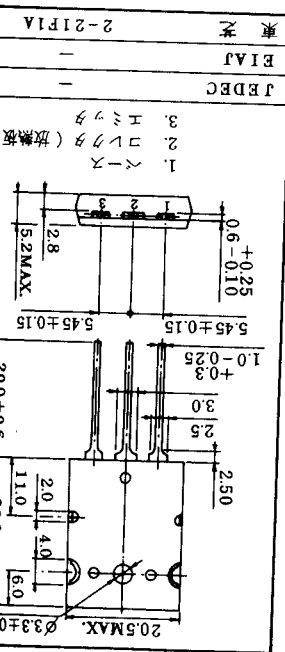
($I_{CP} = 8A, I_B = 2A$)
 : $t_f = 0.15\mu s$ (標準) ($I_{CP} = 8A, I_{B1}(end) = 1.5A$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	V
コレクタ電流 (直流)	I_C	A
コレクタ電流 (パルス)	I_{CP}	A
ベース電流	I_B	A
コレクタ損失	P_C	W
接合温度	T_j	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 1700V, I_B = 0$	—	—	1
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	100
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 3A$	10	18	30
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 8A, I_B = 2A$	—	—	50
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 8A, I_B = 2A$	—	—	20
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_C = 0.1A$	1	3	—
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	400	—
スイッチング特性	蓄積時間	t_{stg}	—	2.5	40
	下降時間	t_f	—	0.15	0.3
抵抗負荷 (図2)	蓄積時間	t_{stg}	—	20	30
	下降時間	t_f	—	0.1	0.2



2SC4532

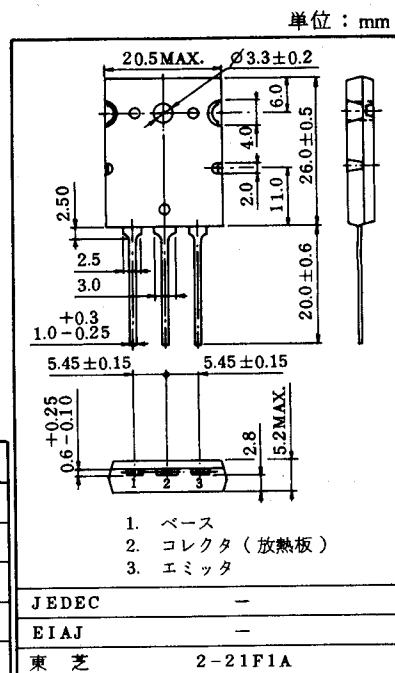
シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ

- 高精度ディスプレイ水平出力用
- カラーテレビ水平出力用
- カラーテレビスイッチング電源出力用

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CB0} \geq 1700V$
- ・ 飽和電圧が低い。 : $V_{CE(sat)} \leq 5V$
($I_{CP} = 8A, I_B = 2A$)
- ・ スwitchング時間が速い。
: $t_f = 0.15\mu s$ (標準) ($I_{CP} = 8A, I_{B1(end)} = 1.5A$)

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	1700	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	600	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流 (直流)	I_C	10	A
コレクタ電流 (パルス)	I_{CP}	20	A
ベース電流	I_B	6	A
コレクタ損失	P_C	200	W
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目		記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=1700V, I_E=0$	—	—	1	mA
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
直 流 電 流 増 幅 率		h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=3A$	10	18	30	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=8A, I_B=2A$	—	—	5.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C=8A, I_B=2A$	—	—	2.0	V
トランジション周波数		f_T	$V_{CE}=10V, I_C=0.1A$	1	3	—	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	400	—	pF
スイッチング時間	インダクタンス負荷 (図1)	蓄積時間	$I_{CP}=8A, I_{B1}=1.5A, f_H=64kHz$ $L_Y=130\mu H, C_Y=5600pF$	—	2.5	4.0	μs
		下降時間		—	0.15	0.3	
	抵抗負荷 (図2)	蓄積時間	$I_{CP}=8A, I_{B1}=1.5A$ $I_{B2}=-3.0A, R_L=25\Omega$	—	2.0	3.0	
		下降時間		—	0.1	0.2	